

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】本開示に係る基板処理方法は、シリコン含有誘電体膜を有する基板を基板支持器に準備する工程と、水素とフッ素を含むガスを含む処理ガスからプラズマを生成して前記シリコン含有誘電体膜をエッチングする工程とを含み、前記エッチングする工程は、前記処理ガスをチャンバ内に供給する工程と、前記基板支持器又は前記上部電極に前記プラズマを生成するための第1の高周波信号を供給する電力供給工程と、上部電極に第1の電気バイアスを印加する工程とを含む。

【選択図】 図3